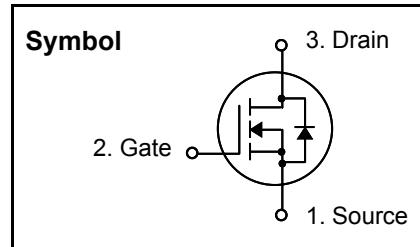


## Logic N-Channel MOSFET

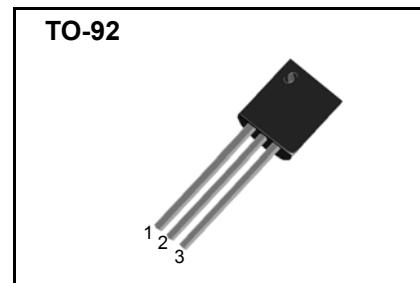
### Features

- $R_{DS(on)}$  (Max 5  $\Omega$ ) @  $V_{GS}=10V$
- $R_{DS(on)}$  (Max 5.3 $\Omega$ ) @  $V_{GS}=4.5V$
- Gate Charge (Typical 0.5nC)
- Maximum Junction Temperature Range (150°C)



### General Description

This Power MOSFET is produced using planar DMOS technology. And this Power MOSFET is well suited for Battery switch, Load switch, Motor controller and other small signal switches.



### Absolute Maximum Ratings

Symbol	Parameter	Value	Units
$V_{DSS}$	Drain to Source Voltage	60	V
$I_D$	Continuous Drain Current(@ $T_A = 25^\circ C$ )	200	mA
$I_{DM}$	Drain Current Pulsed (Note 1)	500	mA
$V_{GS}$	Gate to Source Voltage	$\pm 20$	V
$P_D$	Total Power Dissipation Single Operation ( $T_A=25^\circ C$ )	0.4	W
	Total Power Dissipation Single Operation ( $T_A=70^\circ C$ )	3.2	mW
$T_{STG}, T_J$	Operating Junction Temperature & Storage Temperature	- 55 ~ 150	°C
$T_L$	Maximum Lead Temperature for soldering purpose, 1/8 from Case for 10 seconds.	300	°C

### Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Value			Units
		Min.	Typ.	Max.	
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	-	-	312.5	°C/W

# 2N7000

---

## Electrical Characteristics ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted )

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
<b>Off Characteristics</b>						
$BV_{DSS}$	Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0\text{V}, I_D = 250\mu\text{A}$	60	-	-	V
$\Delta BV_{DSS}/\Delta T_J$	Breakdown Voltage Temperature coefficient	$I_D = 250\mu\text{A}$ , referenced to $25^\circ\text{C}$	-	48	-	$\text{mV}/^\circ\text{C}$
$I_{DSS}$	Drain-Source Leakage Current	$V_{DS} = 60\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}$ $V_{DS} = 60\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, T_J = 125^\circ\text{C}$	-	-	1 1000	$\mu\text{A}$
$I_{GSS}$	Gate-Source Leakage, Forward	$V_{GS} = 20\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$			100	nA
	Gate-Source Leakage, Reverse	$V_{GS} = -20\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$	-	-	-100	nA
<b>On Characteristics</b>						
$V_{GS(\text{th})}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu\text{A}$	1.0	-	2.5	V
$R_{DS(\text{ON})}$	Static Drain-Source On-state Resistance	$V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 500\text{mA}$ $V_{GS} = 4.5\text{ V}, I_D = 75\text{mA}$	- -	1.55 1.9	5 5.3	$\Omega$
<b>Dynamic Characteristics</b>						
$C_{iss}$	Input Capacitance	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{V}, f = 1\text{MHz}$	-	20	25	pF
$C_{oss}$	Output Capacitance		-	11	14	
$C_{rss}$	Reverse Transfer Capacitance		-	3	4	
<b>Dynamic Characteristics</b>						
$t_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	$V_{DD} = 30\text{V}, I_D = 200\text{mA}, R_G = 50\Omega$ $V_{GS} = 10\text{ V}$ (Note 2,3)	-	4	18	ns
$t_r$	Rise Time		-	2.5	15	
$t_{d(off)}$	Turn-off Delay Time		-	17	44	
$t_f$	Fall Time		-	7	24	
$Q_g$	Total Gate Charge	$V_{DS} = 30\text{V}, V_{GS} = 4.5\text{V}, I_D = 200\text{mA}$ (Note 2,3)	-	0.5	0.65	nC
$Q_{gs}$	Gate-Source Charge		-	0.15	-	
$Q_{gd}$	Gate-Drain Charge(Miller Charge)		-	0.2	-	

## Source-Drain Diode Ratings and Characteristics

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
$I_S$	Maximum Continuous Diode Forward Current		-	-	200	mA
$V_{SD}$	Diode Forward Voltage	$I_S = 200\text{mA}, V_{GS} = 0\text{V}$ (Note 2)	-	-	1.2	V

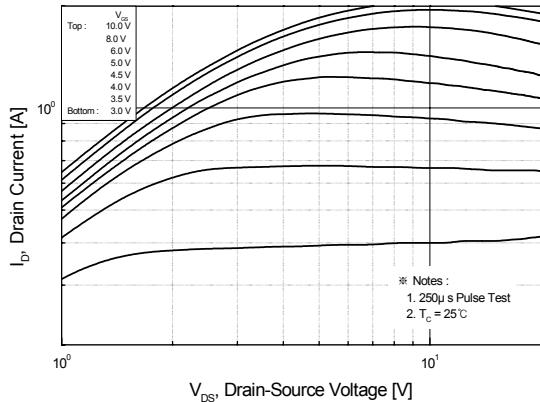
### \* NOTES

1. Repeatability rating : pulse width limited by junction temperature
2. Pulse Test : Pulse Width  $\leq 300\text{us}$ , Duty Cycle  $\leq 2\%$
3. Essentially independent of operating temperature.

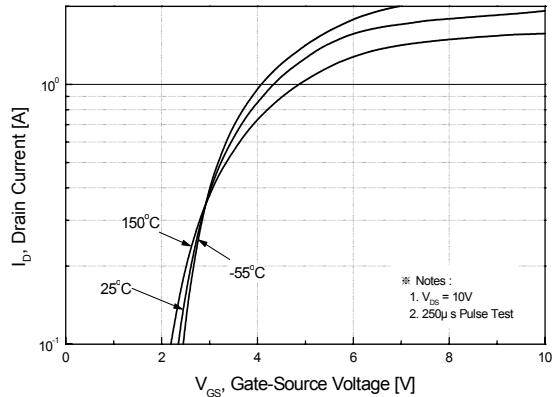


# 2N7000

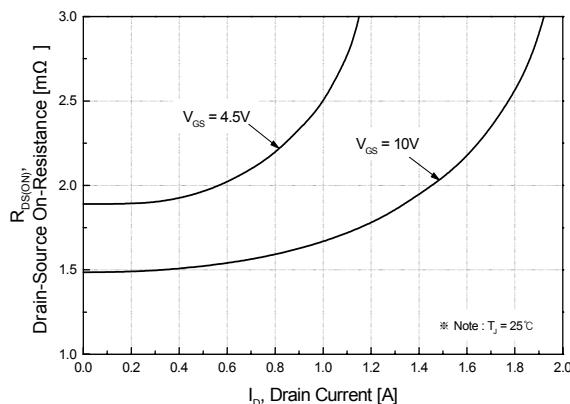
**Fig 1. On-State Characteristics**



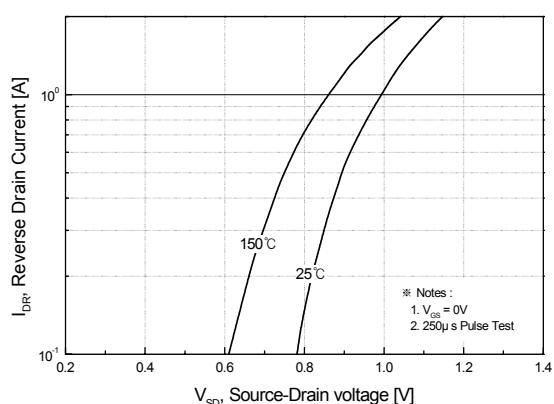
**Fig 2. Transfer Characteristics**



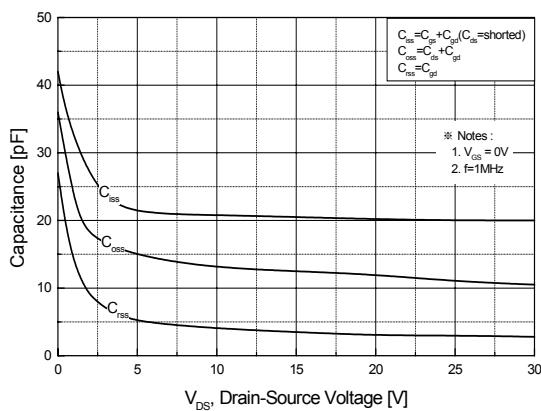
**Fig 3. On Resistance Variation vs. Drain Current and Gate Voltage**



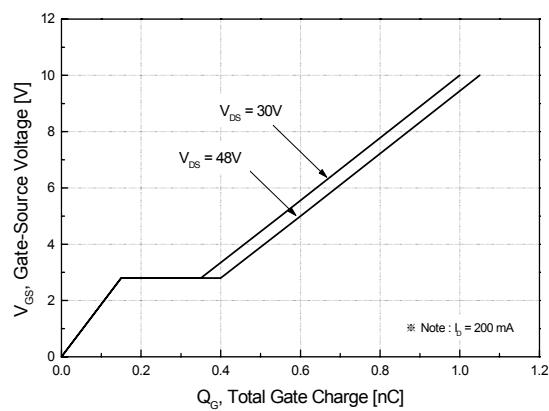
**Fig 4. On State Current vs. Allowable Case Temperature**



**Fig 5. Capacitance Characteristics**



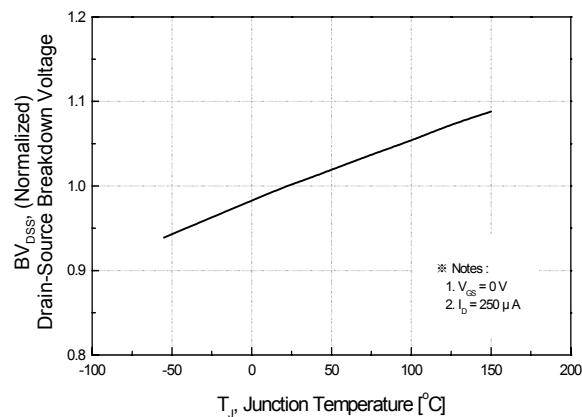
**Fig 6. Gate Charge Characteristics**



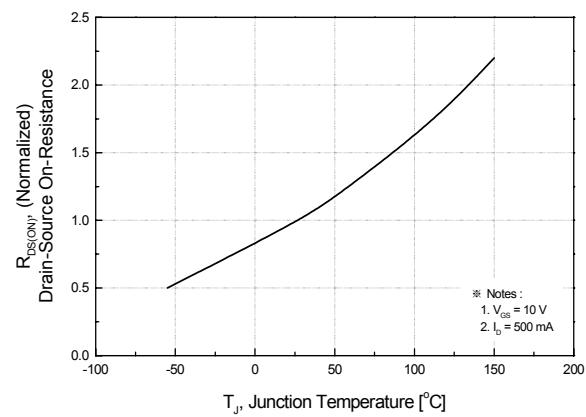
# 2N7000

---

**Fig 7. Breakdown Voltage Variation  
vs. Junction Temperature**



**Fig 8. On-Resistance Variation  
vs. Junction Temperature**



# 2N7000

Fig. 9. Gate Charge Test Circuit & Waveforms

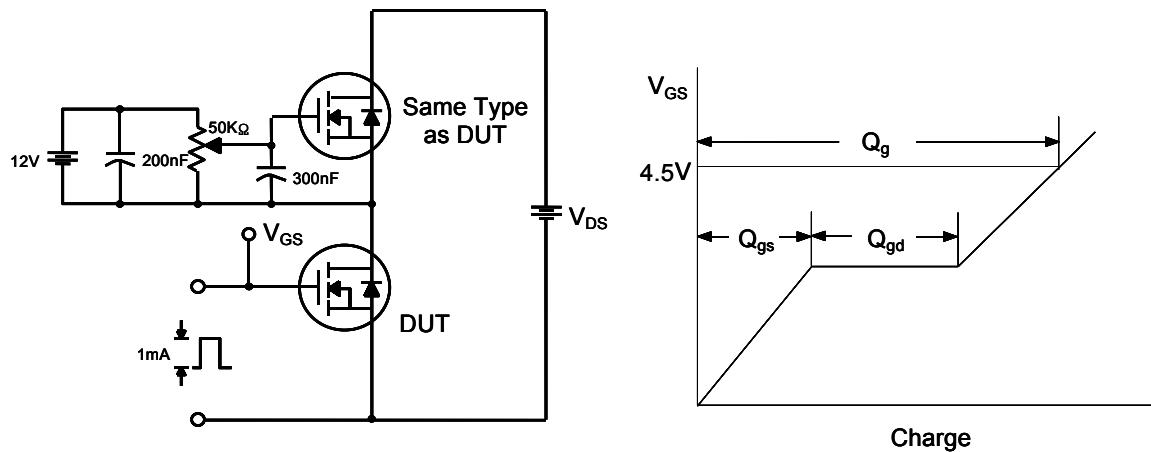
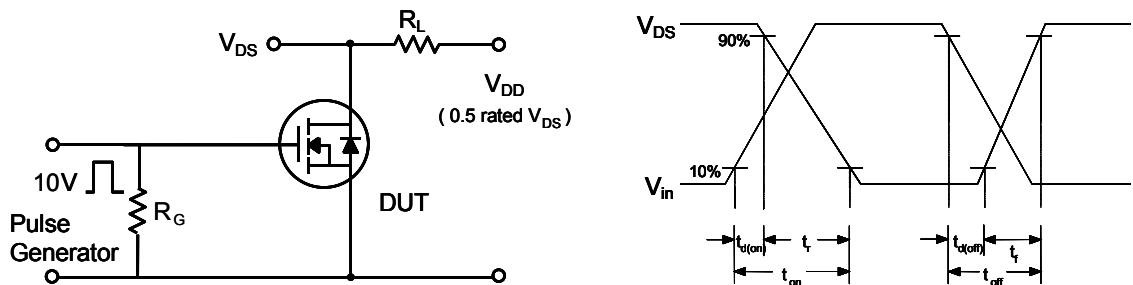


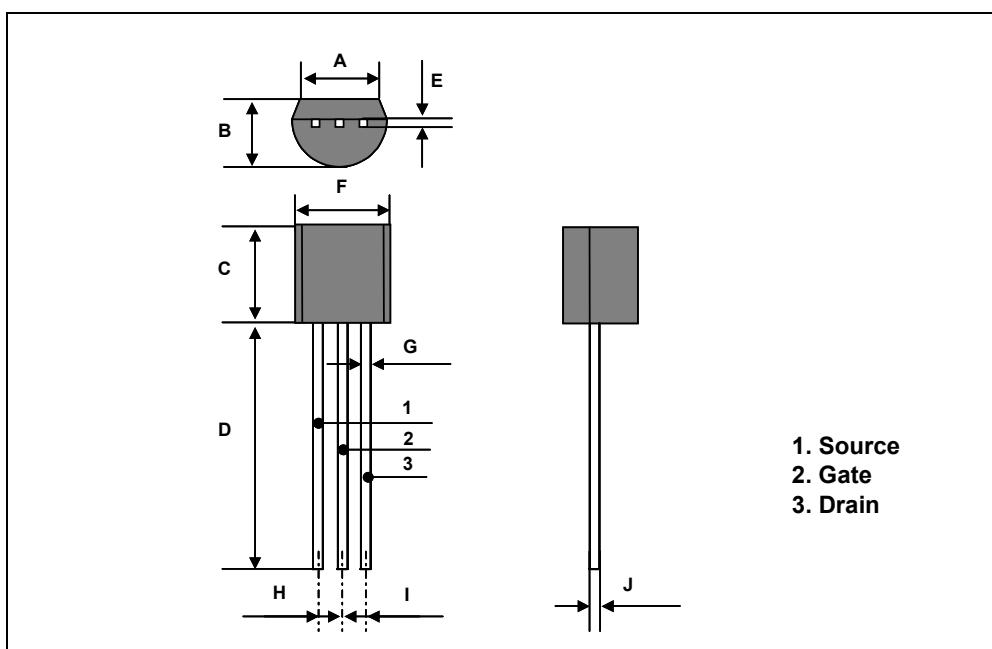
Fig 10. Switching Time Test Circuit & Waveforms



# 2N7000

## TO-92 Package Dimension

Dim.	mm			Inch		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A		4.2			0.165	
B			3.7			0.146
C	4.43		4.83	0.174		0.190
D	14.07		14.87	0.554		0.585
E			0.4			0.016
F	4.43		4.83	0.174		0.190
G			0.45			0.017
H		2.54			0.100	
I		2.54			0.100	
J	0.33		0.48	0.013		0.019





# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А